

ZD7.5

硅外延平面稳压二极管芯片 (4")

■用途:

*用于稳压电路

■特征:

*稳压范围 7.5V(±5%)

*耗散功率 0.5W

*适用于 SOT-23 封装

*有效图形数: 56150 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	350μm×350μm
压焊区尺寸	180μm×180μm
芯片厚度	180±10μm
锯片槽宽度	50μm
金属层	正面: Al 2.3±0.2μm 背面: Au 1.4±0.2μm

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	典型值	单位
稳压值	V_Z	$I_Z=5.0\text{mA}$	7.0	7.9	7.5	V
输出阻抗	Z_{ZT}	$I_{ZT}=5.0\text{mA}$		15		Ω
	Z_{ZK}	$I_{ZK}=1.0\text{mA}$		80		Ω
反向漏电流	I_R	$V_R=5.0\text{V}$		1		μA
正向电压	V_F	$I_F=10\text{mA}$		0.9		V